

ICS 29.045
H 80



中华人民共和国国家标准

GB/T 32279—2015

硅片订货单格式输入规范

Specification for order entry format of silicon wafers

2015-12-10 发布

2017-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC 203)和全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会(SAC/TC 203/SC 2)共同提出并归口。

本标准起草单位:万向硅峰电子股份有限公司、浙江省硅材料质量检验中心、杭州海纳半导体有限公司、南京国盛电子有限公司、有研新材料股份有限公司、浙江金瑞泓科技股份有限公司、江苏协鑫硅材料科技发展有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本标准主要起草人:朱兴萍、楼春兰、戴文仙、毛卫中、赵纪平、王飞尧、马林宝、孙燕、李慎重、林清香、杨素心、邹剑秋。

硅片订货单格式输入规范

1 范围

本标准规定了硅片订货单的格式要求和使用。

本标准适用于硅单晶研磨片、硅单晶抛光片、硅单晶外延片、太阳能电池用硅单晶切割片、太阳能电池用多晶硅片的订货单格式,其他半导体材料的订货单可参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 1550 非本征半导体材料导电类型测试方法
- GB/T 1551 硅单晶电阻率测定方法
- GB/T 1553 硅和锗体内少数载流子寿命测定 光电导衰减法
- GB/T 1554 硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法
- GB/T 1555 半导体单晶晶向测定方法
- GB/T 1557 硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法
- GB/T 1558 硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法
- GB/T 4058 硅抛光片氧化诱生缺陷的检验方法
- GB/T 6618 硅片厚度和总厚度变化测试方法
- GB/T 6619 硅片弯曲度测试方法
- GB/T 6620 硅片翘曲度非接触式测试方法
- GB/T 6621 硅片表面平整度测试方法
- GB/T 6624 硅抛光片表面质量目测检验方法
- GB/T 11073 硅片径向电阻率变化的测量方法
- GB/T 12965 硅单晶切割片和研磨片
- GB/T 13387 硅及其他电子材料晶片参考面长度测量方法
- GB/T 13388 硅片参考面结晶学取向 X 射线测试方法
- GB/T 14139 硅外延片
- GB/T 14140 硅片直径测量方法
- GB/T 14142 硅外延层晶体完整性检验方法 腐蚀法
- GB/T 14144 硅晶体中间隙氧含量径向变化测量方法
- GB/T 14264 半导体材料术语
- GB/T 14847 重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法
- GB/T 19921 硅抛光片表面颗粒测试方法
- GB/T 24578 硅片表面金属沾污的全反射 X 光荧光光谱测试方法
- GB/T 26068 硅片载流子复合寿命的无接触微波反射光电导衰减测试方法
- GB/T 26071 太阳能电池用硅单晶切割片
- GB/T 29055 太阳电池用多晶硅片